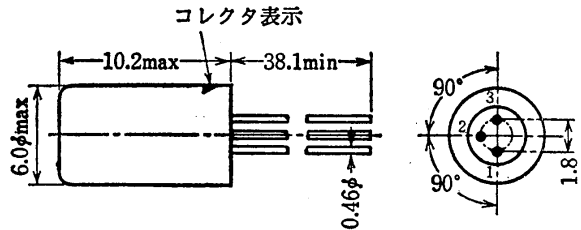


2SC984

シリコン NPN
エピタキシャルプレーナ形
HiFi 出力増幅用



1. エミッタ 2. ベース 3. コレクタ

■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	50 V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	50 V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4 V
コレクタ電流	I_C	500mA
許容コレクタ損失	P_O	350mW
接合部温度	T_j	175 °C
保存温度	T_{stg}	-55~+175 °C

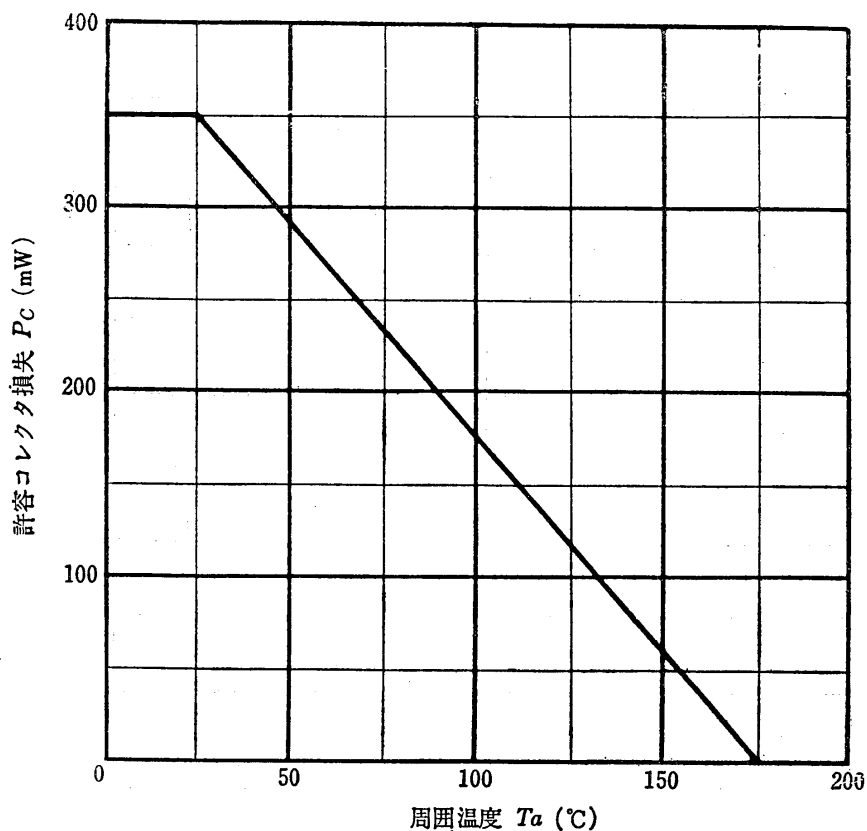
■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

	最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ破壊電圧 $V_{(BR)CEO}$ ($I_C=1\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$)	30	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧 $V_{(BR)EBO}$ ($I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	4	—	—	V
コレクタ遮断電流 I_{CBO} ($V_{CB}=20\text{V}$, $I_E=0$)	—	—	0.5	μA
直流電流増幅率*				
h_{FE} ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)	40	80	320	
直流電流増幅率				
h_{FE} ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=100\text{mA}$)	40	80	320	
コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ ($I_C=150\text{mA}$, $I_B=15\text{mA}$)	—	0.4	1.0	V
ベース・エミッタ電圧 V_{BE} ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)	—	0.6	—	V
利得帯域幅積 f_T ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)	—	100	—	MHz

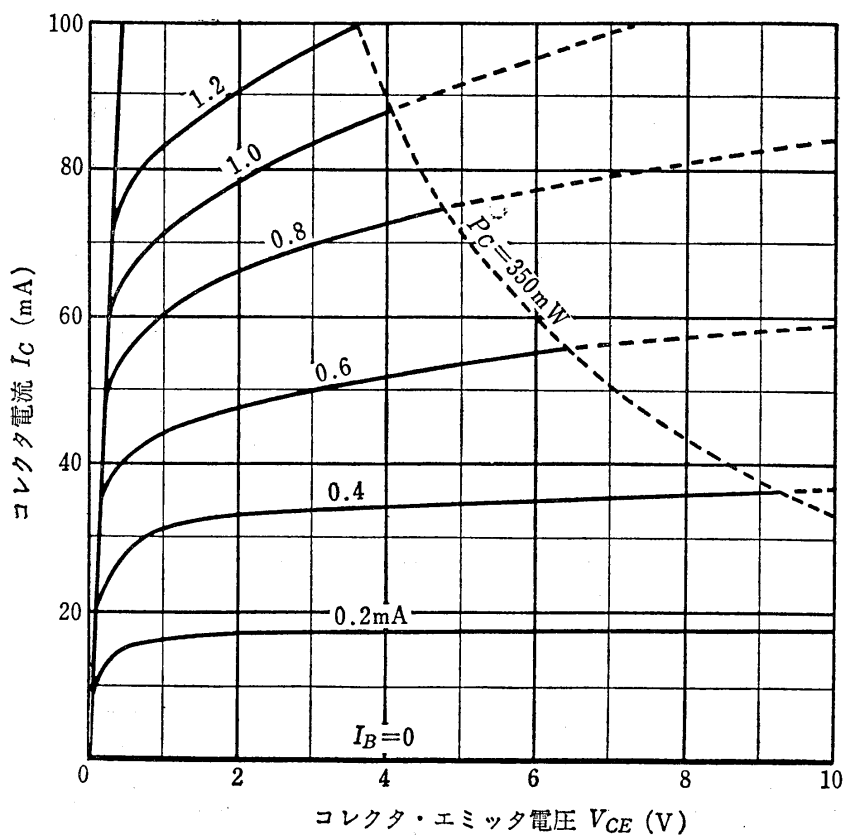
* 2SC984 は h_{FE} の値により下記のように3区分し、現品にそれぞれ ㉒, ㉓, ㉔, ㉕ と表示しております。

㉒ 40~70 ㉓ 60~120 ㉔ 100~200 ㉕ 120~320

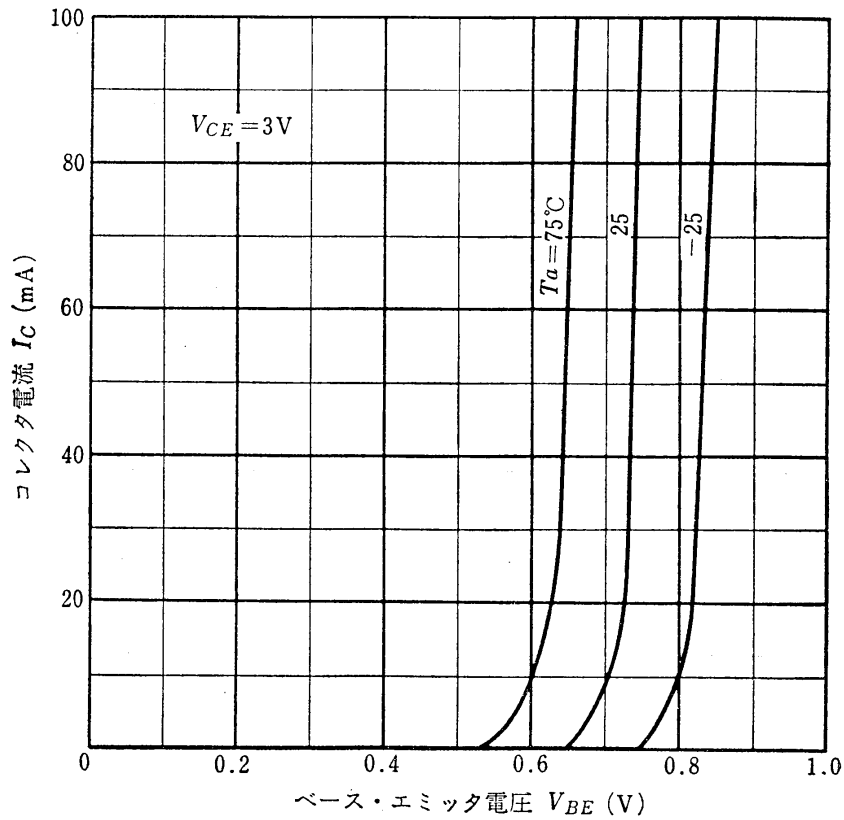
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



エミッタ接地出力静特性



エミッタ接地伝達静特性



直流電流増幅率対コレクタ電流特性

